

## บทที่ 3

### วิธีการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึง ขั้นตอนการเตรียมและการตรวจสอบชิ้นงานที่ใช้ในงานวิจัย โดยเริ่มจากการเตรียมผงแบเรียมไบทเนต (BT) และการเตรียมผงแบเรียมไบทเนตที่เจือด้วยเหล็กและไนโอล์เบียม ( $\text{Fe}^{3+}/\text{Nb}^{5+}$  doped BT) และกระบวนการประคบด้วยชิ้นงานเซรามิก จากนั้นจึงกล่าวถึง ขั้นตอนการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่เตรียมได้ โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ตามลำดับดังนี้

#### 3.1 การเตรียมชิ้นงาน

ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการเตรียมผงของสารทุกรายการด้วยการเลือกใช้เทคนิค mixed - oxide เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดของสารตั้งต้นทั้งหมดแสดงไว้ในตาราง 3.1

ตาราง 3.1 แสดงลักษณะเฉพาะของสารตั้งต้นที่ใช้ศึกษา

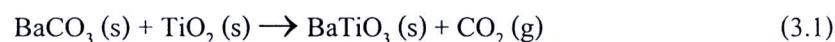
สารตั้งต้น	บริษัทที่ผลิต	มวลโมเลกุล	ความบริสุทธิ์ (%)
$\text{BaCO}_3$	Sigma-Aldrich	197.34	99.00
$\text{TiO}_2$	Sigma-Aldrich	79.87	$\geq 99.00$
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	SIAL	159.69	99.98
$\text{Nb}_2\text{O}_5$	Aldrich	265.81	99.99

เริ่มจากการซั่งสารตั้งต้นตามที่ได้คำนวณไว้ นำมาใส่ในกระป่องพลาสติกที่บรรจุลูกบด เชอร์โภเนีย (ball-milling) หรือ agate (vibro-milling) เติมอุทานอลลงไปช่วยในการหล่อลื่น นำไปผ่านกระบวนการบดย่อยสมสารด้วยเทคนิค ball-milling (หรือ vibro-milling) เป็นเวลานาน แตกต่างกัน ซึ่งในกระบวนการบดย่อยนี้จะช่วยลดการเกาตัวกันของอนุภาคนาด

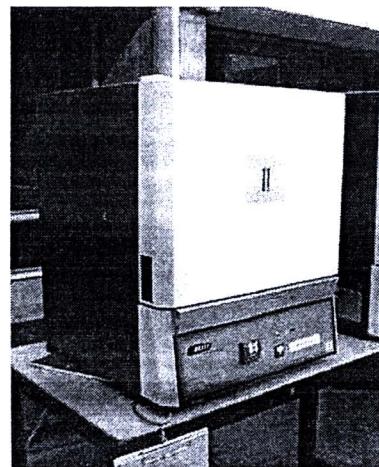
อนุภาคให้เล็กลงด้วย แล้วจึงนำสารผสมที่ได้ไปอบให้แห้ง จากนั้นก็นำผงผสมที่ได้ใส่ลงในถ้วยอลูมินาปิดฝาให้สนิท แล้วนำไปเผาแคลไชน์ด้วยไฟฟ้า (รูป 3.1) ดังแผนภาพแสดงในรูป 3.2

### 3.1.1 การเตรียมผงแบบเริยมไไทเทเนตที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร

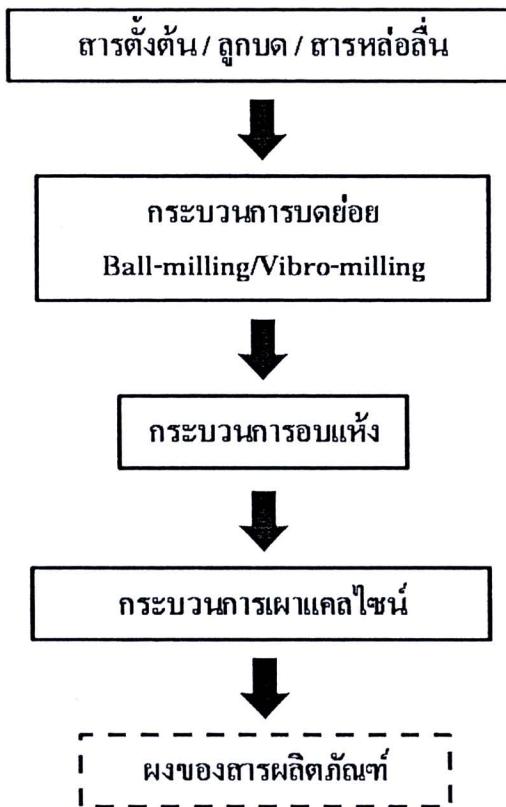
ทำการเตรียมผงแบบเริยมไไทเทเนต ( $\text{BaTiO}_3$ ) จากปฏิกิริยาของสารตั้งต้น  $\text{BaCO}_3$  และ  $\text{TiO}_2$  โดยอาศัยสมการเคมีที่ (3.1) ดังนี้



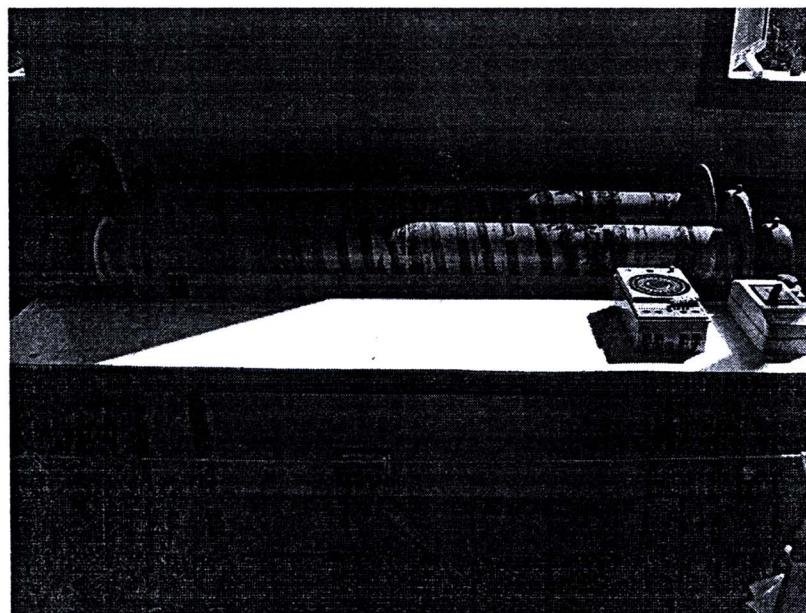
ทำการผสมสารตั้งต้นโดยการ Ball-milling (รูป 3.3) เป็นเวลานาน 10, 20 และ 30 ชั่วโมง ตามลำดับ นำไปเผาแคลไชน์ที่อุณหภูมิ  $800\text{-}1300\text{ }^\circ\text{C}$  เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึ้น/ลง อุณหภูมิ  $5\text{ }^\circ\text{C}/\text{นาที}$  [36] โดยอาศัยแผนผังในการแคลไชน์ดังรูป 3.4 แล้วจึงนำสารที่ได้ไปตรวจสอบด้วยเทคนิค XRD เพื่อหาปริมาณเฟสของ BT ที่เกิดขึ้น และอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการเตรียมสาร BT ที่มีเฟสบิสูทธิ์ต่อไป



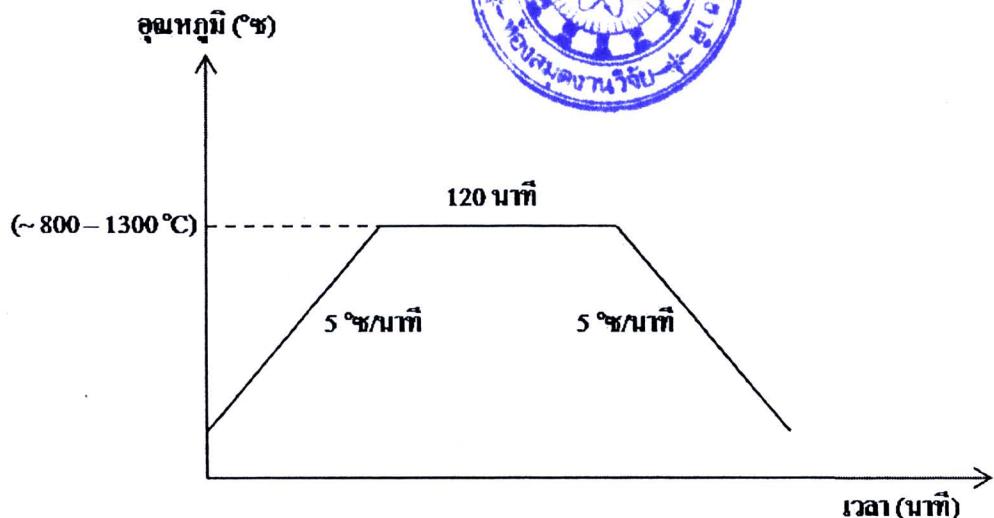
รูป 3.1 เตาไฟฟ้าสำหรับเผาสาร



รูป 3.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการเตรียมผงผลิตภัณฑ์ที่ใช้



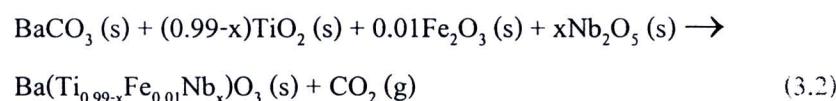
รูป 3.3 เครื่องบดย่อยผสมสารแบบ Ball-milling



รูป 3.4 แผนผังแสดงการเผาเคลดไชน์ที่ใช้ในการเตรียมผง BT

### 3.1.2 การเตรียมผงแบบเรียบไทเทเนตที่เข้าด้วยเหล็กและไนโตรบียม

ทำการเตรียมผงแบบเรียบไทเทเนตที่เข้าด้วยเหล็กและไนโตรบียมด้วยวิธี mixed-oxide โดยอาศัยสมการเคมีที่ (3.2) ดังนี้



ในงานวิจัยนี้ได้เลือกทำการเตรียมสารที่มีค่า  $x$  เท่ากับ 0.01 และ 0.025 โดยใช้เทคนิค Vibro-milling (รูป 3.5) ในการบดอย่างผสมสารเป็นเวลานาน 0.5 ชั่วโมง จากนั้นนำผงผสมที่ได้ไปเผาเคลดไชน์ที่อุณหภูมิ  $\sim 1100-1250$  °ช เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึ้น/ลงอุณหภูมิ 5 °ช/นาที [35] ตามแผนผังการเคลดไชน์ในรูป 3.4 แล้วจึงนำสารที่ได้ไปตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิค XRD ต่อไป

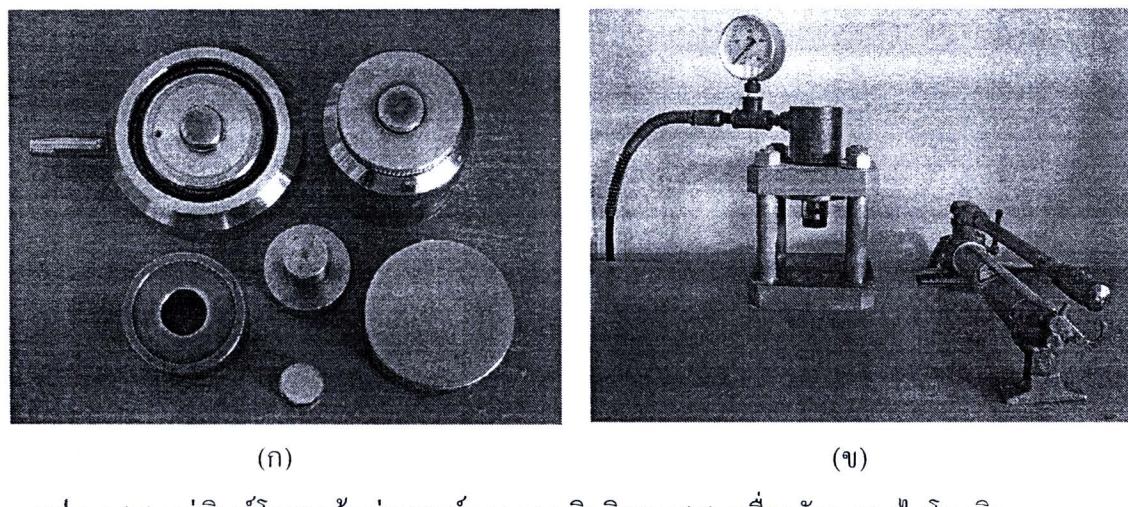


รูป 3.5 เครื่องบดย่อยผสมสารแบบ Vibro-milling

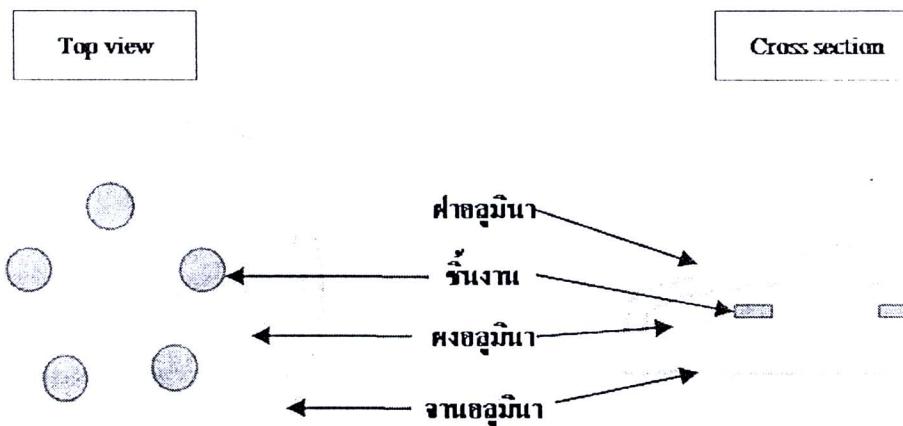
### 3.1.3 กระบวนการประดิษฐ์เซรามิก (Ceramic Fabrication)

ในกระบวนการประดิษฐ์เซรามิกทุกระบบจะผสม Polyvinyl Alcohol (PVA) ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยน้ำหนักกลงไปด้วยประมาณ 1-2 หยด เพื่อเป็นตัวช่วยประสานให้ผงเกาะกันตื้อขึ้น จากนั้นนำผงที่เตรียมได้มาทำการอัดขึ้นรูปแบบ uniaxial pressing จะได้ชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นแผ่นกลม (disk) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มิลลิเมตร โดยทำการอัดในแม่พิมพ์โลหะ ด้วยเครื่องอัดระบบไฮโตรลิก (รูป 3.6 (ก) และ (ข)) ด้วยความดัน 100-150 เมกะ帕斯คัล เป็นเวลา 15-20 วินาที เมื่อได้ชิ้นงานที่ผ่านการอัดขึ้นรูป (green body) แล้วจึงนำมาจัดเรียงลงบนแผ่นฐานอลูмин่าที่มีผงอลูминารองเป็นพื้นอยู่ (รูป 3.7) จากนั้นปิดด้วยฝาอลูмин่า แล้วนำไปเผาชินเตอร์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ

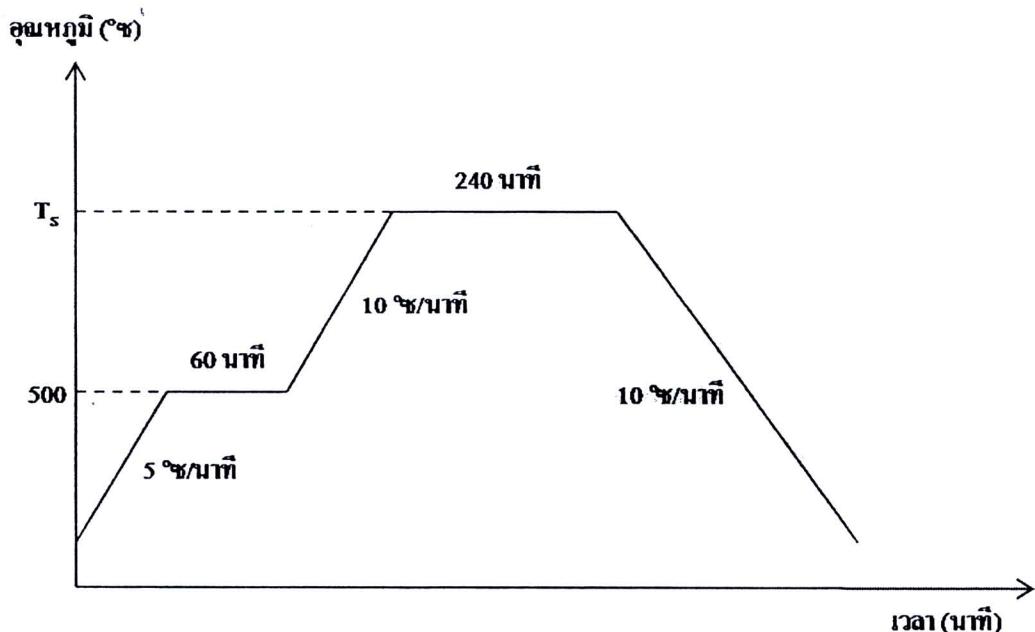
โดยในการเผาชินเตอร์สารจะเริ่มด้วยการให้ความร้อนด้วยอัตราการขึ้น/ลงอุณหภูมิเป็น 5 ° ช/นาที ไปถึงที่อุณหภูมิ 500 ° ซ แล้วคงความร้อนไว้ที่อุณหภูมิดังกล่าวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อกำจัด PVA ออกໄປ จากนั้นจึงทำการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปจนถึงอุณหภูมิเผาชินเตอร์ โดยในกรณีของการเตรียมเซรามิก BT จะอยู่ในช่วง 1325-1450 ° ซ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึ้น/ลงอุณหภูมิเป็น 10 ° ช/นาที (ดังแสดงในรูป 3.8)



รูป 3.6 (ก) แม่พิมพ์โลหะเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร (ข) เครื่องอัดระบบไฮดรอลิก



รูป 3.7 การจัดเรียงชิ้นงานบนแพ่นงานอุบัติฯสำหรับการเผาชินเตอร์



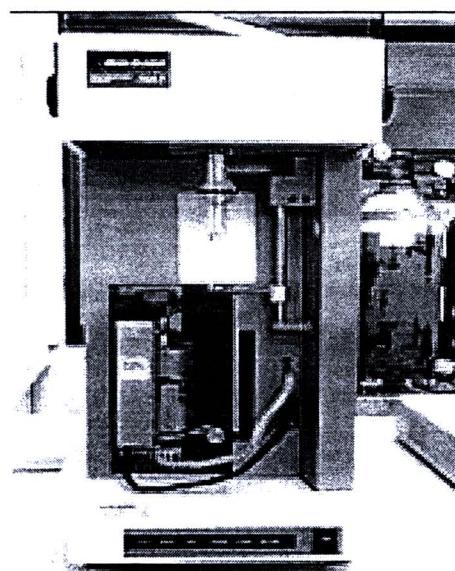
รูป 3.8 แผนผังแสดงการเผาซินเตอร์ของเซรามิก BT ( $T_s$  คืออุณหภูมิที่ใช้ในการเผาซินเตอร์)

ส่วนเซรามิกในระบบแบบเรียมไทเทเนตที่เจือด้วยเหล็กและไนโอลบียมสูตร  $Ba(Ti_{0.99-x}Fe_{0.01}Nb_x)O_3$  ที่มีค่า  $x = 0.01$  และ  $x = 0.025$  ใช้อุณหภูมิเผาซินเตอร์อยู่ในช่วง 1300-1400 °ช และ 1350-1450 °ช ตามลำดับ โดยเผาเป็นเวลานาน 4 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึ้น/ลงอุณหภูมิเป็น 10 °ช/นาที

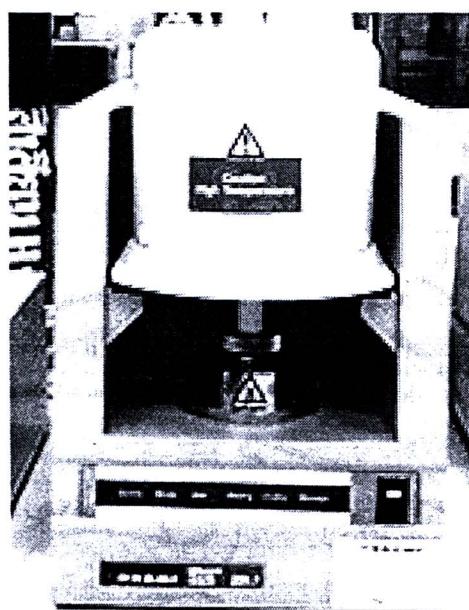
### 3.2 การตรวจสอบขั้นงาน

#### 3.2.1 การวิเคราะห์ทางความร้อนด้วยเทคนิค Thermogravimetric analyzer และ Differential scanning calorimetry (TGA-DSC)

พฤติกรรมการสูญเสียน้ำหนัก และการสลายตัวของผงที่ยังไม่ได้เผาเคลื่อนไหว อันเนื่องมากจากความร้อนนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเทคนิค Thermogravimetric analyzer และ Differential scanning calorimetry โดยนำผงที่ต้องการวิเคราะห์ปริมาณเล็กน้อยใส่ลงในถ้วยที่ทำมาจากแพลตทินัม แล้วใส่ลงไปในเครื่องมือที่ใช้ทดสอบ Perkin Elmer TGA7 (รูป 3.9) และ Perkin Elmer DSC7 (รูป 3.10) และใช้ผงอลูมินาเป็นตัวอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ จากนั้นให้ความร้อนจากอุณหภูมิห้องไปจนถึง 1300 °ช ด้วยอัตรา 10 °ช/นาที [37]



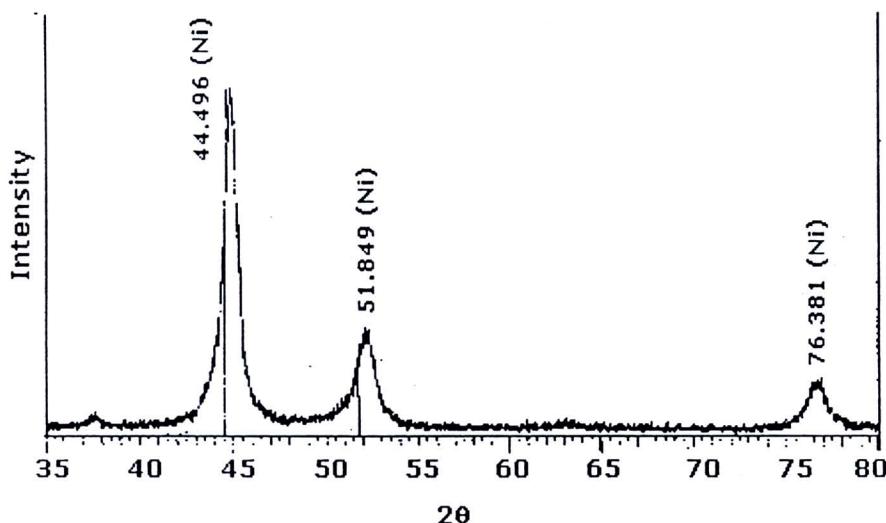
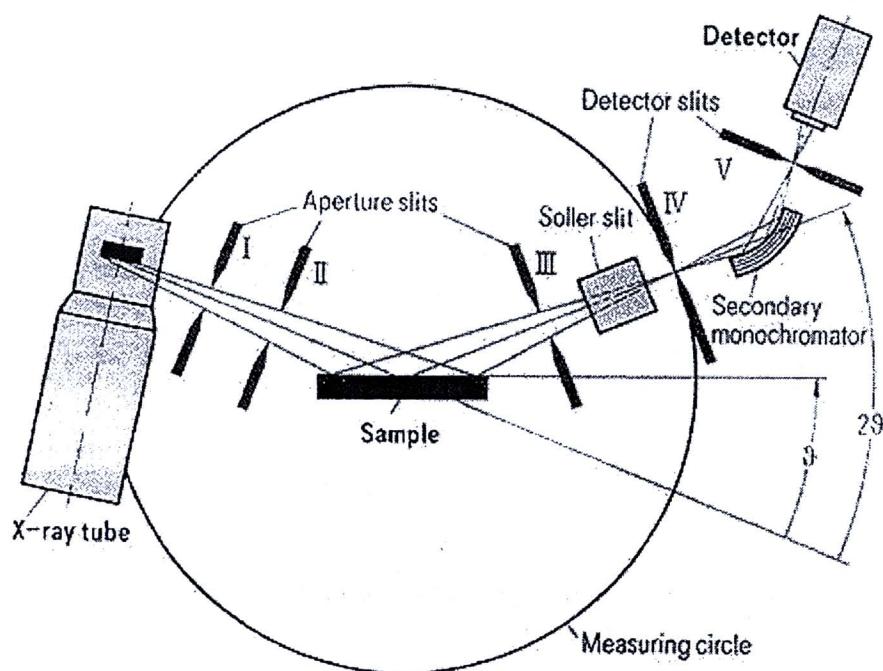
รูป 3.9 เครื่องวิเคราะห์ Thermogravimetric (Perkin Elmer TGA7)



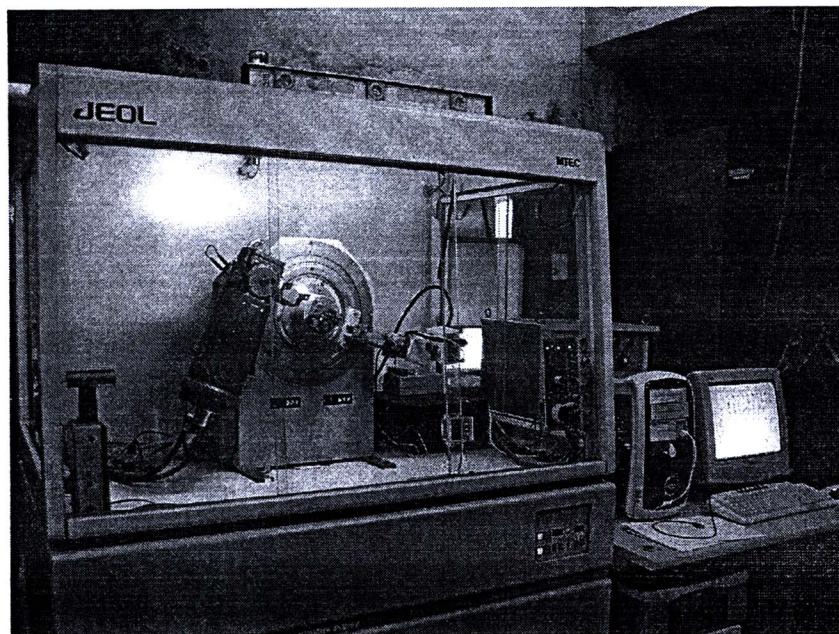
รูป 3.10 เครื่องวิเคราะห์ Differential scanning calorimetry (Perkin Elmer DSC7)

### 3.2.2 การตรวจสอบไฟฟ้าด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD)

ในงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffraction technique) ในการตรวจสอบทางนิคและปริมาณของเฟสที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการตัดกราบทบของรังสีเอ็กซ์ลงบนผิววัสดุแล้วเกิดการกระเจิง (scattering) และเลี้ยวเบนโดยมีมุมในการเลี้ยวเบนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้างผลึกและระนาบ ( $hkl$ ) ที่รังสีตัดกราบทบภายในวัสดุ โดยที่รูปแบบของการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของวัสดุแต่ละชนิดนั้นก็จะมีความเฉพาะเจาะจงสำหรับวัสดุนั้น ๆ ดังนั้นมี่อนนำเครื่องมือสำหรับตรวจวัด (detector) นารองรับรังสีเอ็กซ์ที่กระเจิงออกมานاحกัวสดุในตำแหน่งต่าง ๆ ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าวัสดุนั้นเป็นวัสดุหรือสารชนิดใด โดยพิจารณาจากข้อมูลของความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมของเบราก (Bragg's angle) และความเข้มของพิรังสีเอ็กซ์ของรูปแบบการเลี้ยวเบนที่ปรากฏ (รูป 3.11) ซึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสารแต่ละชนิดจะมีรูปแบบของการเลี้ยวเบนที่เป็นลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป จึงสามารถนำรูปแบบของการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ที่ตรวจสอบได้มาเปรียบเทียบกับข้อมูลของสารชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS files) [38] เพื่อตรวจสอบชนิดของเฟสที่เกิดขึ้นได้ โดยเริ่มจากการนำผงและชิ้นงานเซรามิกที่เตรียมได้มาแพคใส่ใน holder จากนั้นนำไปวางที่บริเวณช่องสำหรับวางชิ้นงานในเครื่อง X-ray diffractometer (รูป 3.12) และจึงเดินเครื่องโดยใช้เป้าทองแดง ( $CuK\alpha$ ) ที่ให้รังสีเอ็กซ์ค่าความยาวคลื่นประมาณ  $1.54 \text{ \AA}$  ออกมายวดๆ step ประมาณ 5 องศาต่อนาที จากค่ามุม  $2\theta$  ที่  $20$  องศา ไปจนถึงที่ค่ามุม  $2\theta$  ที่  $60$  องศา



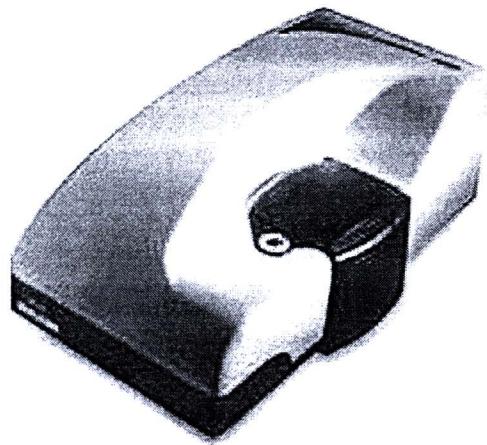
รูป 3.11 หลักการตรวจสอบเฟสด้วยเทคนิค XRD และตัวอย่าง รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์



รูป 3.12 เครื่อง X-ray diffractometer รุ่น JDX-8030

### 3.2.3 การวิเคราะห์การกระจายตัวขนาดอนุภาค (Particle size distribution analysis)

ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการตรวจสอบการกระจายตัวของขนาดอนุภาคโดยใช้เทคนิค laser diffraction โดยเริ่มจากการนำผงที่เตรียมໄให้ไปทำการกระจายตัวในอะซิโตน (acetone) ด้วยเครื่องอัลตราโซนิกเป็นเวลาประมาณ 20 นาที จากนั้นนำไปหยดลงในเซลล์ความตัน แล้วนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์อนุภาค (รุ่น Nano S) ดังแสดงในรูป 3.13 ซึ่งสามารถวิเคราะห์อนุภาคที่มีขนาดอยู่ในช่วง 0.5-10000 นาโนเมตรได้



รูป 3.13 เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle size analyzer)

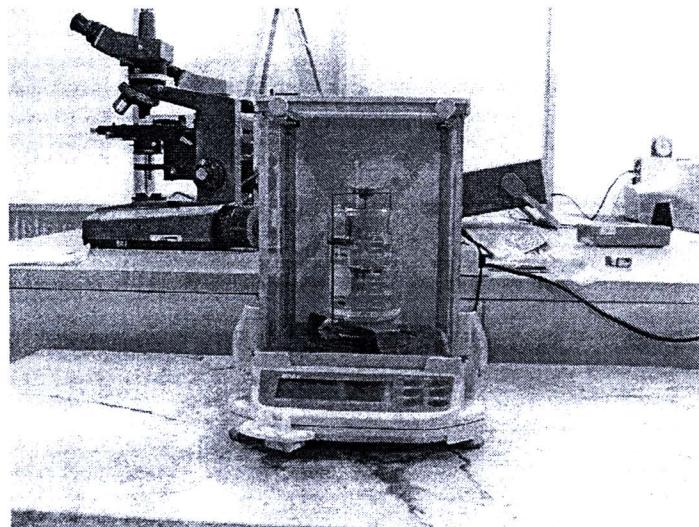
### 3.2.4 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของเซรามิก

#### 3.2.4.1 การหาค่าความหนาแน่น (density)

ทำการหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานเซรามิกที่เตรียมได้ โดยอาศัยหลักการแทนที่น้ำของอาร์คิเมดีส (Archimedes) โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้การแทนที่ของไชลีน (Xylene) แทนการแทนที่ของน้ำเริ่มจากนำเซรามิกที่ต้องการทราบค่ามาแช่ในไชลีนเป็นเวลานาน 15-20 นาที จากนั้นจึงนำมาซึ่งในไชลีน ( $W_1$ ) ซึ่งขณะเปียก ( $W_2$ ) และนำไปปอนในเตาอบให้แห้งนาน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาซึ่งขณะแห้ง ( $W_3$ ) ด้วยเครื่องซึ่งคิดตลอดฐาน  $\rho_c = \frac{W_1}{W_2 - W_3} \times \rho_{xylene}$  แล้วจึงนำค่าที่ได้มาคำนวณหาความหนาแน่นตามสมการ (3.3) ดังนี้

$$\rho_c = \left( \frac{W_1}{W_2 - W_3} \right) \times \rho_{xylene} \quad (3.3)$$

เมื่อ  $\rho_c$  และ  $\rho_{xylene}$  คือ ความหนาแน่นของเซรามิก และของไชลีนที่อุณหภูมิขณะทำการทดลอง  
 $W_1$ ,  $W_2$  และ  $W_3$  คือ น้ำหนักของเซรามิกที่ซึ่งในอากาศขณะแห้ง ขณะเปียก และในไชลีน  
 ตามลำดับ



รูป 3.14 เครื่องชั่งดิจิตอลสำหรับใช้หาค่าความหนาแน่นตามหลักของ Archimedes

### 3.2.4.2 การหาค่าการหดตัวหลังการเผา (shrinkage)

หลังจากผ่านกระบวนการเผาซินเตอร์เรียบร้อยแล้วจะนำเซรามิกที่ได้มาตรวจสอบหาค่าการหดตัวของเซรามิกภายหลังการเผาในรูปของการหดตัวเชิงเส้น (linear shrinkage) ด้วยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเซรามิกก่อน และหลังการเผาซินเตอร์ จากนั้นจึงนำค่าที่ได้มาคำนวณหารือถลอกการหดตัวของเซรามิกจากสมการ (3.4) ดังนี้

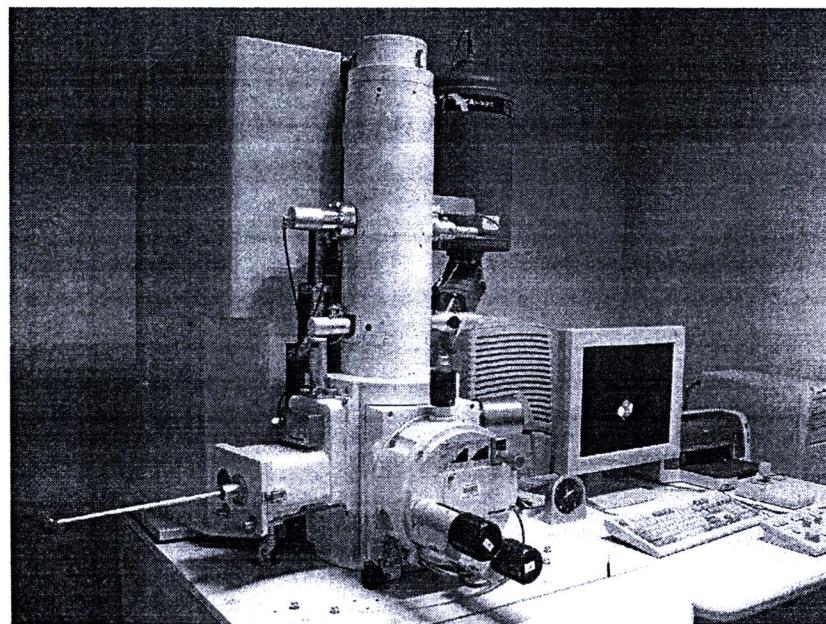
$$\text{การหดตัว (\%)} = \left( \frac{R_1 - R_2}{R_1} \right) \times 100 \quad (3.4)$$

เมื่อ  $R_1$  และ  $R_2$  เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเซรามิกก่อนและหลังการเผาซินเตอร์ตามลำดับ

### 3.2.5 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค (Microstructural Analysis)

ในการตรวจสอบลักษณะสัณฐานของผง และโครงสร้างจุลภาคของเซรามิกที่เตรียมได้นั้น จะใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒 (SEM) ดังแสดงในรูป 3.15 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ โครงสร้างจุลภาค และสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่เตรียมได้ สำหรับการเตรียมชิ้นงานที่เป็นผงจะเตรียมโดยทำให้เกิดการกระจายตัวในอุตสาหกรรมด้วยการใช้เครื่องอัลตราโซนิกเป็นเวลากว่า 15-30 นาที แล้วนำไปขยายคงบนแท่น

ทองเหลือง (stub) ที่ติดเทปทองแดงไว้แล้ว ส่วนชิ้นงานที่เป็นเซรามิกสามารถเตรียมได้จากการนำชิ้นงานมาทำความสะอาดด้วยเครื่องอัลตราโซนิก เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกไปจากผิวหน้าชิ้นงาน จากนั้นนำไปบนไฟแห้ง แล้วจึงหักชิ้นงานออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำแต่ละชิ้นไปติดบนแท่นทองเหลืองด้วยเทปการ์บอน โดยจัดให้ผิวหน้า (surface) และรอยแตก (fracture) วางตัวอยู่ในแนวที่เหมาะสมต่อการสำรวจด้วยเทคนิค SEM แล้วทำการเคลือบผิวของชิ้นงานเป็นเวลานาน 30 วินาที โดยเซรามิกแบบเรียบไม่เทเนตจะใช้ทองคำในการเคลือบผิว ส่วนเซรามิกในระบบแบบเรียบไม่เทเนตที่เจือด้วยเหล็กและในโซบียม จะใช้การ์บอนในการเคลือบผิว จากนั้นจึงนำไปทำการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานต่อไป



รูป 3.15 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) รุ่น JEOL JSM-840A

### 3.2.6 การวัดสมบัติไดอิเล็กทริก (Dielectric Measurement)

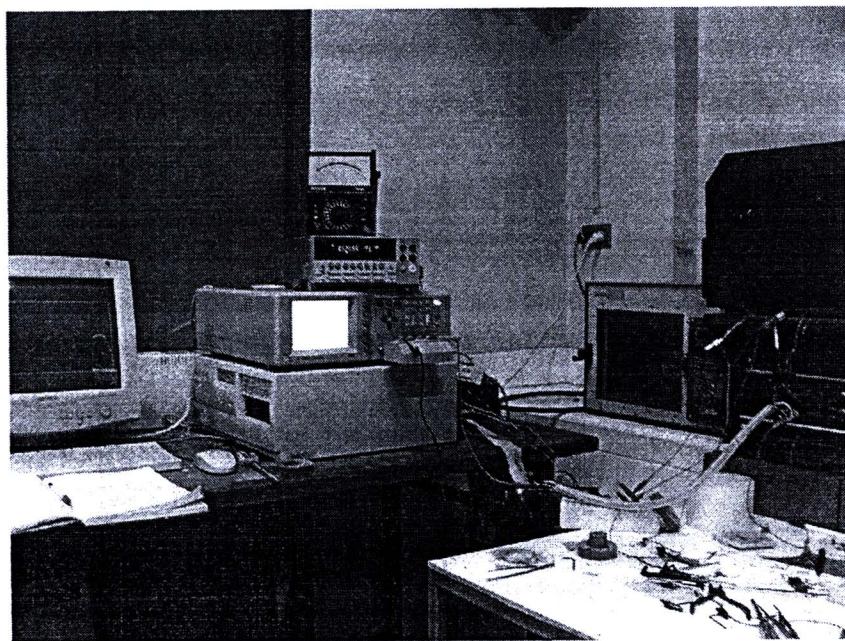
ในงานวิจัยนี้ จะทำการวัดค่า relative permittivity และ dielectric loss ด้วยเครื่อง LCR meter (TH2819A, Tonghui Inc.) ดังแสดงในรูป 3.16 โดยจะทำการวัดที่ความถี่ตั้งแต่ 100 เฮิรตซ์ – 100 กิโลเฮิรตซ์ และอุณหภูมิตั้งแต่ 30 – 250 °C ใน การเตรียมชิ้นงานสำหรับวัดสมบัติไดอิเล็กทริก นั้น ก่อนอื่นต้องทำการขัดผิวนานาชิ้นงานด้วยกระดาษทรายตั้งแต่เบอร์ 600-1200 แล้วจึงนำไปทำการทำข้าวอิเล็กโทรด โดยการเคลือบผิวด้วยทองทึ้งสองหน้าของเซรามิก โดยที่เต่าจะหน้าใช้เวลาในการเคลือบผิวนาน 1 นาที จากนั้นนำไปทำการวัดเพื่อนำมาคำนวณหาค่า relative permittivity ( $\epsilon_r$ ) ดังสมการที่ (3.5)

$$\epsilon_r = \frac{Cd}{\epsilon_0 A} \quad (3.5)$$

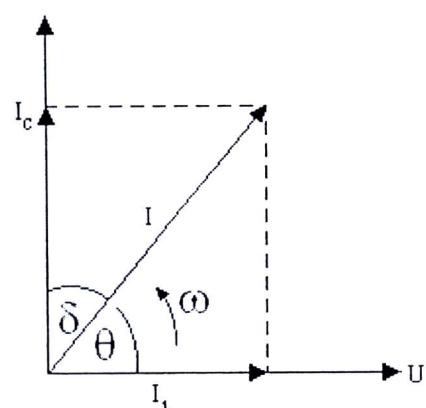
เมื่อ	C	คือ ค่า Capacitance
	d	คือ ความหนาของชิ้นงาน
	A	คือ พื้นที่ของข้าวอิเล็กโทรด
	$\epsilon_0$	คือ ค่า permittivity ของสูญญากาศมีค่าเท่ากับ $8.854 \times 10^{-12}$ F/m

เมื่อวัสดุไดอิเล็กทริกอยู่ในสถานไฟฟ้ากระแสสลับ พฤติกรรมของวัสดุจะต่างออกไปจากเมื่อยู่ในสถานไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานไฟฟ้ากระแสสลับ สถานไฟฟ้าจะสลับตามรูปแบบของคลื่นไอน์ ( $E=E_r \sin \omega t$ ) ดังนั้น เมื่อให้สถานไฟฟ้ากระแสสลับแก่าวัสดุไดอิเล็กทริก ไดโพลภายในวัสดุไดอิเล็กทริกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาตามความถี่ของสถานไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้ ณ ความถี่สูง ไดโพลจะกลับตัวไม่ทันกับสถานไฟฟ้าที่ให้ ส่งผลให้เกิดรีแลก เชชัน (relaxation) ขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า สถานไฟฟ้าเป็นพลังงานแบบหนึ่งซึ่งเมื่อให้สถานไฟฟ้าแก่าวัสดุไดอิเล็กทริก ไดโพลในวัสดุไดอิเล็กทริกจะใช้พลังงานที่ให้ในการกลับตัวไปมา แต่เมื่อที่ความถี่สูง ๆ ไดโพลจะกลับตัวตามความถี่ไม่ทัน เมื่อกลับไม่ทันไดโพลจึงไม่กลับตัวและเมื่อไม่กลับตัว แต่ยังรับพลังงานจากสถานไฟฟ้าอยู่ พลังงานที่สารไดรับจะค่อยๆ สะสมจนเกิดเป็นความร้อนขึ้นเป็นการสูญเสียในวัสดุไดอิเล็กทริก

ตามทฤษฎีจะไม่เกิดการสูญเสียขึ้น แต่ในความเป็นจริงกระแสไฟฟ้าอยู่  $90^\circ$  ส่งผลให้เกิดการสูญเสียขึ้น เรียกแทน  $\tan \delta$  ว่า dissipation factor หรือ loss tangent ดังรูป 3.17 ถ้า  $\mu \delta$  เป็นการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกจะมีค่าน้อยและเรียก  $\mu \delta$  ว่าเป็น loss angle



รูป 3.16 เครื่อง LCR meter(TH2819A, Tonghui Inc.)



รูป 3.17 การนิยาม Loss Tangent ที่เกิดขึ้นในวัสดุodielectric [39]

### 3.2.7 การวัดสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก (Ferroelectric Measurement)

งานวิจัยนี้ ทำการวัดค่า polarization ด้วยเครื่องวัดสมบัติเฟอร์โรอิเล็กทริก โดยใช้วงจร Sawyer-Tower (รูป 3.18) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีระบบวัดสำหรับหาลักษณะความเป็นเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบ non-linear สามารถใช้ได้กับชิ้นงานที่เป็นพิล์มนบางและเซรามิก หลังจากที่ทำการขัดผิวชิ้นงานด้วยผงอลูминีียมแล้ว ก็นำชิ้นงานที่ได้ไปทำข้ออิเล็กโทรดด้วยการเคลือบผิวด้วยทองทั้งสองหน้าของเซรามิก แล้วจึงนำไปทำการวัดวงวนฮิสเทอเรชิส (P-E) โดยให้สนามไฟฟ้าตั้งแต่ 5 – 30 กิโลโวลต์/เซนติเมตร โดยใช้ความถี่ในการวัด 50 Hz ซึ่งการวัดวงวนฮิสเทอเรชิสในการทดลองนี้จะใช้วงจรที่เรียกว่า Sawyer-Tower circuit [7] ดังรูป 3.19 จากวงจรนี้จะทำให้สามารถหาค่า polarization เมื่อให้สนามไฟฟ้าค่าต่าง ๆ ได้จากสมการที่ (3.6)

$$P = Q/A \quad (3.6)$$

$$V_x = \text{Applied Voltage} \quad V_y = \text{Voltage @ } C_0$$

ดังนั้น

$$E = \frac{V_x}{t} \text{ unit } (\frac{kV}{cm}) ; t = \text{sample thickness(cm)}$$

$$P = \frac{Q}{A} = \frac{CV_y}{A} \text{ unit } (\frac{\mu C}{cm^2})$$

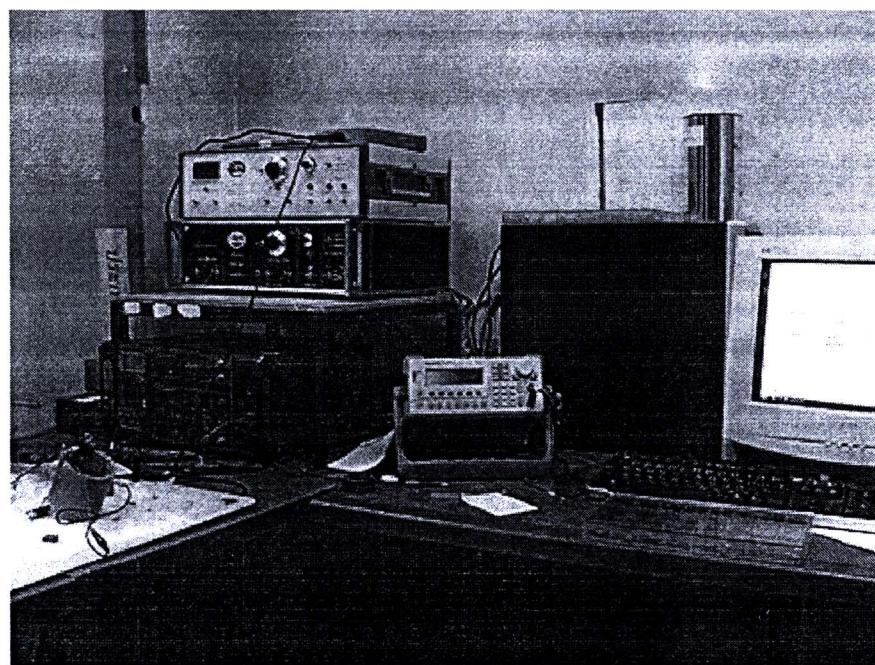
$$\text{which } A = \text{sample Area } (cm^2)$$

$$C = \text{Capacitor @ } C_o (nF)$$

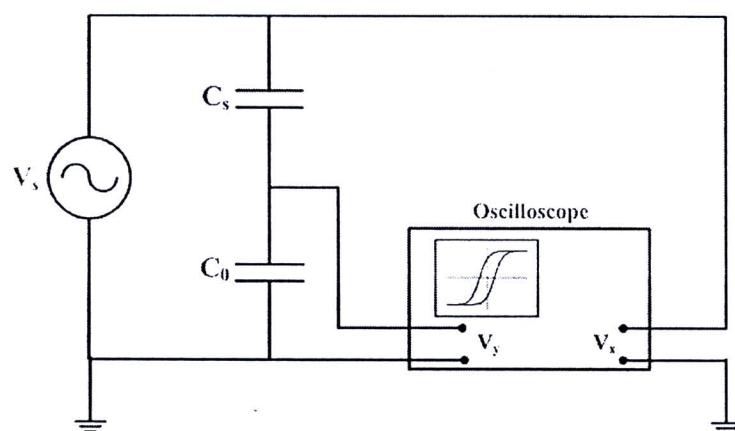
เมื่อ P คือ polarization ( $C/m^2$ )

Q คือ ประจุบนพื้นผิwtawเก็บประจุ (C)

A คือ พื้นที่ตัวเก็บประจุ ( $m^2$ )



รูป 3.18 แสดงเครื่องวัดวงวนชิสเทอเรชิส



รูป 3.19 แผนผังวงจร Sawyer-Tower ( $C_0 = 0.1 \mu\text{F}$ ,  $C_s = \text{Sample}$ ,  $C_0 \gg C_s$ ) [7]